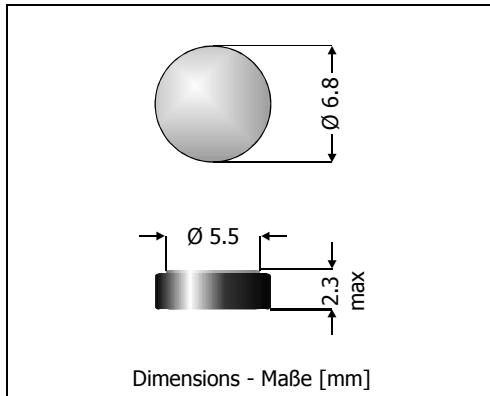


AG12A ... AG12M
Silicon Rectifier Cells with Polysiloxane Cover
Silizium-Gleichrichterzellen mit Polysiloxan-Abdeckung

Version 2007-07-26



Nominal current 12 A

Nennstrom

Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V

Periodische Spitzensperrspannung

Weight approx. – Gewicht ca. 0.3 g

Standard packaging bulk

Standard Lieferform lose

**Maximum ratings****Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
AG12A	50	80
AG12B	100	130
AG12D	200	250
AG12G	400	450
AG12J	600	700
AG12K	800	1000
AG12M	1000	1300

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	12 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	60 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	500/550 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	1250 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 12\text{ A}$	V_F	< 0.95 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 μA

1 Max. temperature of the cell $T = 150^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Zelle $T = 150^\circ\text{C}$